

241854

基木館藏

电 真 空 器 件
制 造 工 艺 学

下 册 第一分册

H. A. 布利斯庫諾夫 著
И. Я. 卡美涅茨基



高等教育出版社



电 真 空 器 件 制 造 工 艺 学

下 册 第一分册

H. A. 布利斯庫諾夫著
И. Я. 卡美涅茨基

清华大学无线电系电真空
器件制造工艺教研组译

高等 教育 出 版 社

本書系根据苏联專家布利斯庫諾夫 (Н. А. Бирскунов) 和卡美涅茨基 (И. Я. Каменецкий) 在清华大学和在我国工作期間所編寫的講義“電真空器件制造工艺学” (Технология электровакуумных приборов) 下册底稿譯出的。

“电真空器件制造工艺学”下册将分成三册出版。在第一分册中包括阴極、热子和收气剂的制造工艺；第二分册中包括栅極、阳極、辅助零件及管壳的制造工艺；第三分册中包括陶瓷、管基，焊泥的制造工艺以及封口、排气、裝管基等工艺。

在第一分册中詳細地叙述了制造阴極、热子和收气剂的材料及其制造工艺。作者在著述本書时吸取了电真空器件生产实践中的最新成就，而对某些問題也作了精煉的理論分析。本書可作为高等学校电真空器件专业工艺課程的主要参考書，也可以供科学研究人员，工程技术人员以及中等技术学校师生閱讀。

本書由清华大学无线电系电真空器件制造工艺教研組徐明星譯出，由陈克强校訂。

电真空器件制造工艺学

下册 第一分册

H. A. 布利斯庫諾夫 И. Я. 卡美涅茨基

清华大学无线电系电真空

器件制造工艺教研組譯

高等教育出版社出版 北京宣武門內教基路7号

(北京市书刊出版业营业登记证字第054号)

人民教育印刷厂印刷 新华书店发行

第一分册 15010·500 开本 650×1168 1/16 印数 5 1/2 版次 2

字数 158,000 印数 0001—5,500 定价(7)元 0.95

1959年4月第1版 1959年4月北京第1次印刷

序 言

以电真空器件的广泛發展为基础的現代电子学，可以給我們解决許多复杂的各种各样性質的問題。

在苏联，对于技术电子学、特別是电真空器件制造工艺学所給予的重視，是和它在社会主义工业中及苏联共产党第二十次代表大会的历史性決議里所規定的宏偉的共产主义建設綱領中的意義完全相适应的。

目前，在工业中，在實驗室技术中，在国民经济的各部門和现代物理学中，电真空器件得到了最广泛的应用。現在电子管在各種不同的条件和設備中的应用，例如，在計算-分析机中，在不用維护人員的設備和仪器等中，要求着器件的工作可靠及寿命久長，而不需專門的維护。所有这一切都向大量生产的电子管及其制造工艺提出了更高的要求。

最近，愈来愈迫切地需要有一本能反映电真空器件制造工艺現状的書。因为現有的 A. A. 依凡諾夫(Иванов)著的“电真空工艺学”(Электровакуумная технология, 1944 年出版) 和 B. 欧斯必(Өспе)与 M. 克諾尔(Киоль)合著的“电真空材料工艺学”(Технология электровакуумных материалов, 1939 年出版) 等，都已經相当陈旧了，并且現在已經有点象圖書館中的珍品了。

著者在这一領域里長期工作的过程中，产生了写作一本“电真空器件制造工艺学”的企圖。在这本書里，首先想把現在用得最广的、具有熾热阴極和用非聚焦电子束进行静电控制的电真空器件(即电子管)的制造工艺來作一个比較詳細的和有系統的叙述，但不包括超高頻器件制造工艺的特殊問題。

著者并不企圖对电子管制造工艺的一切問題加以全面的阐述。因为这一任务非常困难，电真空器件的制造工艺涉及科学和技术的各个領域，著者当然不可能对各方面都是內行的。

根据著者的原意，本書應該是一本供給大学生用的教学参考書；但对于在相应的工业部門里从事工作的工程技术人员，也可能有用。

在这本“电真空器件制造工艺学”一書的第一分册(中文版为下册第一分册——譯者)中，叙述了各种材料的加工及用这些材料制造阴極，热子和收气剂的工艺方法。

最后，著者对斯維脫兰(Светлан)工厂的总工程师和以 B. H. 烏里揚諾夫(列寧)命名的列宁格勒电工学院 [Ленинградский Электротехнический институт им. Ульянова(Ленина)]电真空器件制造工艺教研組主任 P. A. 加夫里罗夫(Гаврилов)表示深深的感謝，因为他不辞辛苦地校訂了本書。作者同时对 P. A. 畢林特尔(Нелендер)教授和 B. H. 莫日維羅夫(Можжеволов)所提出的一系列的宝贵意見表示感謝，这些意見在本書中皆予以考慮了。

在写阴極的碳化一节时，著者得到了工程师 L. A. 拉脫欽科(Радченко)的帮助，而在写本書的手稿时，得到了清华大学电真空器件制造工艺教研組的同事和北京电子管厂工作人员的帮助，著者在此一并向他們表示感謝。

对有助于本書改进的批评与希望，著者将怀着感激的心情予以接受，并請函寄北京清华大学无线电系电真空器件制造工艺教研組轉本人。

著者

目 录

下册 第一分册

序言	iv
第一章 阴极的制造工艺	1
§ 1. 电子管阴极的结构和物理化学性质	1
§ 2. 阴极基金属的材料及其要求	8
§ 3. 直热式阴极基·金属材料的化学清洗和电化学清洗	19
§ 4. 纱丝和薄带的机械检验及在氢气中的退火·纱丝的涂青铜	25
§ 5. 直热式阴极基金属的成形	32
§ 6. 劳热式阴极基金属的机械加工	38
§ 7. 劳热式阴极基金属的清潔处理	46
§ 8. 劳热式阴极基金属的热加工和阴极基金属的合成	65
§ 9. 氧化物塗料的材料及其制造工艺	78
§ 10. 将氧化物塗料塗敷到阴极的基金属上去	88
§ 11. 氧化物阴极的检验	104
§ 12. 阴极的碳化	110
第二章 热子的制造工艺	118
§ 1. 热子基金属的材料及其要求	118
§ 2. 对绝缘涂层的要求及其清潔和检验方法	120
§ 3. 热子基金属的机械制造及其加工工艺	125
§ 4. 将绝缘层塗敷到热子基金属上去的方法	137
§ 5. 热子的烧结	155
§ 6. 热子的加固和检验	157
第三章 收气剂的制造工艺	161
§ 1. 收气剂总論及对收气剂的要求	161
§ 2. 金属银的制备工艺	165
§ 3. 银铝和银镁合金的制备	169
§ 4. 银钛(Bata)和银钍(Baro)收气剂的制备	173
§ 5. 带状银钽收气剂和银铝收气剂的制备	178
§ 6. 管状收气剂(金属管中的银)的制备	184
§ 7. 铅和铈钍的收气涂层	188
§ 8. 磷收气剂	195

第一章 阴極的制造工艺

§ 1. 电子管阴極的結構和物理化学性質

在現代的接收放大管、振蕩管、气体放电管以及其他新型的电真空器件中，作为热电子發射体的，主要有三类阴極：氧化物阴極、鎢阴極和敷釷鎢阴極。而敷釷鎢阴極，在許多情况下都对之进行輔助的碳化处理（見下），以增加其發射性能。

氧化物阴極是由某种金屬（基金屬）及塗敷在其上的一層鹼土金屬（鋇、锶、有时还加入鈣）的碳酸盐組成的。为此，先将这些物質細微的碳酸盐 $(Ba, Sr)CO_3$ 晶粒做成悬浮液，加入少量的粘合剂，然后用种种方法复塗到基金屬的表面上去。这样做成的阴極在管內加热到 1400°K 时，碳酸盐就分解成相应的氧化物，而在分解时放出的气体（其中包括碳酸气），則被抽出管外。

氧化物塗層是一种由复杂的氧化物 $(Ba, Sr)O$ 微晶所形成的多孔層（疏松度为 40—80%），厚度在 20 微米以上，晶粒的大小介于 1—10 微米之間。

在中小型功率管中用得最广泛的阴極是直热式的氧化物阴極（圖 1-1, a）和旁热式的氧化物阴極（圖 1-1, b）。前者是靠直接将电流通过阴極的基金屬而加热的，后者則是靠放在阴極金属套筒中間的热子来加热的。

敷釷鎢阴極首先是由郎繆尔（Ленгмер）和罗得日尔斯（Роджерс）进行詳細研究的，它是一种在表面复有能降低逸出功的釷原子層的鎢絲，鎢絲的形状有种种。

在功率較大的电真空器件中，特別是高阳極电压的振蕩管中，

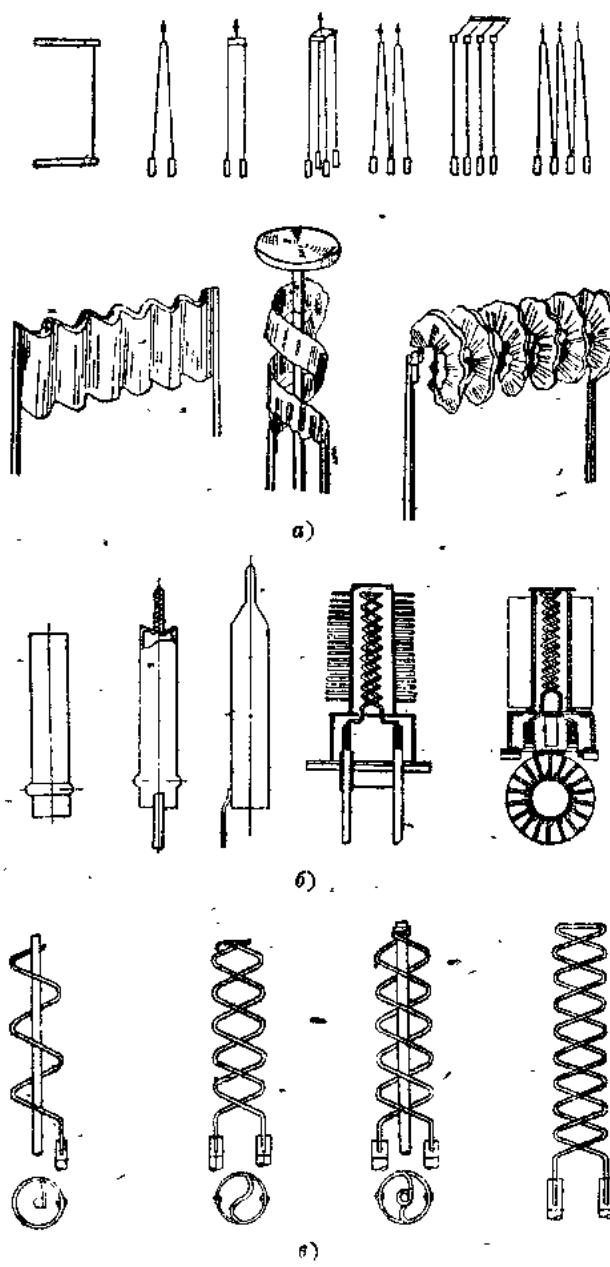


圖 1-1. 电真空器件阴极的结构。

直到目前为止还是采用纯钨阴极(虽然纯钨的发射性能是很小的)或敷钍钨阴极。在图 1-1, 6 上画出了这种阴极常见的几种结构。

在简短地介绍了现代电真空器件中用得最广泛的阴极的类型及其结构后，我们就来讨论一些有关半导体氧化物和敷钍钨阴极的发射原理问题。

氧化物阴极良好的发射性能是在激活以后得到的。激活时将氧化物阴极加热到大约 1400°K ，同时索取发射电流。这样，就还原出金属钼，同时借助于扩散作用而分布在在整个氧化物涂层中。

金属钼的还原是靠了氧化物涂层与基金属杂质间或者与阴极加热时放出的气体(主要是 CO)间的化学作用。除了这些化学反应外，钼的还原也可能是由于当电流通过涂层时所产生的氧化物的电解作用，或由于外来离子轰击氧化物涂层时所发生的热分解作用，以及由于新涂层发热而造成的热分解作用。但是后两种过程的效果是很小的。由于阴极在激活过程中氧化物涂层里充满了自由钼，就使得氧化物涂层由纯介质变成了发射性能很高的杂质型半导体。

在图 1-2, a 上画出了最初建立的钼镍氧化物阴极的能量图。从图中可以看出，导带(6s-Ba)底线位于满带(5P-Ba)上线之上，它们之间的能级空隙是 20—25 电子伏特。剩余钼原子的电子所形成的杂质能级位于 BaO 的相应能带之下，它是提供电子的施主。对于激活良好的阴极，导带底线和施主能级间的能级空隙大约等于 0.6 电子伏特。这一氧化物阴极的能量图以前是当作施主型半导体来研究的，它不足以解释一系列的实验结果。在宽广的温度范围内，和不同的激活程度下对氧化物阴极特性的研究指出，氧化物阴极的导电性不仅是电子型的，同时也是空穴型的^①。根据所得到的实验材料，就有可能重新研究氧化物阴极的导电问题以及建立新的能量图。

在新的能級圖(圖 1-2, 6)①中，假定在鹼土金屬氧化物的晶体里，除了有形成施主的剩余鋇原子外，还有受主。受主的形成是和氧化物陰極中的剩余氧有关。

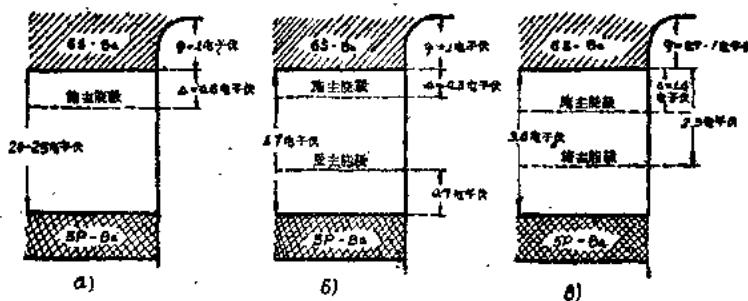


圖 1-2. 氧化物陰極大致的能級圖。

在理解氧化物陰極的物理過程方面，新的能級圖是前進了一步。但是其中某些條件並不是很有根據地簡化了的(如假定受主數不變等)。此外，對於氧化銅單晶中的光吸收和光導電的研究結果表明，導帶底線和施主能級、受主能級以及滿帶上線間的能級空隙，都和圖 1-2, 6 中所給出的不相一致。

在圖 1-2, 6②中給出了修正過的氧化物陰極在激活狀態下的能級圖。這一新的能級圖只是考慮了熱動態平衡，即沒有電流通過時的情況。在這種情況下，在氧化物中可能有二個施主和受主能級，他們和滿帶的上線靠得很近。在激活良好的陰極中，受主能級中充滿了來自施主能級的電子。

① Н. Д. Моргулис, В. С. Яговдик — ДАН. СССР, 59, 247 (1948).

② Du Pre E. K.

Hubner R. A. — Phys. Rev. 78, № 5, 567—571 (1950).

Rittner E. S.

③ Nergaard Z. S. RCA. Rev. 18, № 4 (1953).

目前还不能证实：事实上即使在单晶氧化物阴极中，也只有二个连续的杂质能级，而不是整个连续的能带。P型导电的发现和其他许多实验材料，使我们得出如下的结论：在氧化物中存在着好几种能级^①，它们好象和酸卤化物晶体里的各种中心一样。

图1-2,e中的能级图只适用于热动态平衡时的情况，不适用于有电流通过阴极时的情况，因此不足以解释氧化物阴极中的各种现象。为了解释氧化物阴极中的许多物理过程和现象（也包括反常现象），提出了“当电流通过阴极时靠近阴极发射表面处由于电解作用而缺乏施主”的假说^②。

上述这个为实验结果所证实了的假说的基本概念，可以概括如下：

- 1) 施主有移动性，而且参与电解和扩散作用。
- 2) 当没有电流通过阴极时，施主均匀地分布在氧化物阴极的涂层中。此时就相当于图1-2,e中的能级图。
- 3) 当有电流通过阴极时，由于电解作用和氧化物涂层中的电场作用，施主就趋向阴极的基金属（但不渗入基金属中），因而靠近阴极的发射表面处，就造成了施主不足的表层，该层的厚度随通过阴极电流密度的增加而增加。
- 4) 在平衡状态下，即当通过阴极的电流稳定后，施主的电解作用就被反扩散作用所平衡。

激活良好的氧化物阴极所以具有良好的发射性能，主要是由于施主能级和导带底线间的能级空隙小（0.9—1.4电子伏），而导带底线与表面位能壁垒之间的能级差也只有0.7—1电子伏。这就有可能在提高阴极的温度时使杂质能级中的电子激发到导带

^① Narita sh., J. Phys. Soc. Japan, 7, 221—222 (1952).

^② 见上页脚注^①。

(68-Ba)中去,然后通过表面位能壁发射到真空中去。

利用T. П. 科兹略科夫斯卡娅(Козляковская)和Г. А. 吉吉諾夫(Тягунов)求出的公式^①,可以计算半导体(氧化物阴极)的发射电流密度:

$$I = (1 - \bar{R}) A V \sqrt{N_g} T^{\frac{5}{2}} e^{-\frac{\varphi + \Delta}{kT}}$$

其中: \bar{R} —平均反射系数;

A —常数, $\approx 10^{-6}$ 安/厘米²度⁵;

N_g —每立方厘米中的受主数目;

T —温度 °K;

φ —外逸出功(电子伏);

Δ —内逸出功(电子伏)。

在前面提到了敷针钨阴极比纯钨阴极有着较大的热电子发射性能,这是因为在敷针钨阴极的表面上盖上了一层能降低阴极逸出功的针原子。为了制造这种阴极,要用含有氧化针(占全重的1—2.5%)加成剂的钨丝。当将阴极加热到2600°K,时间为2—3分钟进行热处理(激活)时氧化针就被钨还原成纯金属针。但是在这样的高温下,在阴极的表面不会形成针原子层,因为此时针原子的蒸发表速度大于它向钨丝表面扩散的速度。因此阴极的发射性能和纯钨阴极的发射性能差不多。为了得到针原子层,在预热后,要将温度下降到2000—2300°K。在这样的温度下,针原子沿着钨丝晶粒的界面向表面扩散,在钨丝表面就为吸附力所极化而形成偶极子。偶极子的负极朝向钨丝表面(图1-3)。偶极子的总和就形

① Т. П. Козляковская, Доклад на III Всесоюзной конференции по полупроводникам, май 1984 г. Г. А. Тягунов "Светотехника" № 4, 1984 г.

成了偶电层，其电矩等于单个偶极子的电矩 p 和每平方厘米偶极子数 n 的乘积：

$$M = pn$$

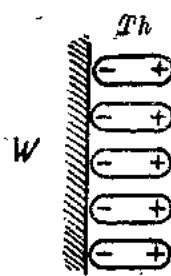


图 1-3. 在钨表面上偶电层的形成。

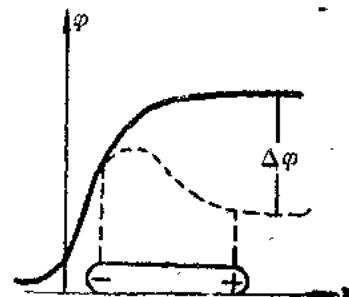


图 1-4. 偶电层对钨的逸出功的影响。

此时由偶电层引起的，电位跳跃 $\Delta\varphi = 4np$ (图 1-4)就降低了纯钨的逸出功 φ_W

$$\varphi = \varphi_W - \Delta\varphi$$

φ ——敷有针原子层的钨阴极的逸出功。

敷针钨阴极激活的程度是以金属表面针层的复盖系数作为标志的。

$$\theta = \frac{n}{n_1}$$

式中： n ——钨表面的实际针原子密度；

n_1 ——钨表面形成单分子层时的针原子密度。

当金属表面针原子的复盖系数增加时，阴极的激活程度也就随着增加，当复盖系数近于 1(大约为 0.7)时，就达到了发射电流的最大值。当系数 θ 继续增加时，阴极的逸出功也就增加，最后接近纯针的逸出功。因而阴极的热电子发射性能也就下降。当

$\theta = 2$ 时，就等于纯针的发射性能。

敷针钨阴极对于提高温度(过热时会去激活)和对于管内各种气体非常敏感。气体的存在会由于化学作用而减低复盖系数 θ ，例如氧气能使针原子氧化，也可能使针层完全破坏。后一种情况当在高的阳极电压下发生气体放电时特别厉害。因此，目前几乎不采用敷针钨阴极。

为了提高阴极的工作温度和削弱离子轰击的作用，将敷针钨阴极进行碳化处理。在碳氢化合物的气体，如汽油、苯等的蒸汽中进行加热，碳氢化合物在热丝的表面就分解而形成自由的碳，扩散到阴极中形成碳化钨。

碳化敷针钨阴极的发射性能和普通的敷针钨阴极完全一样，但对过热和强电场较不敏感。这点可以作如下的解释：针原子和碳化钨间的结合力较大，因此和纯钨相比时，单分子针层在碳化钨上的蒸发表要慢得多。此外，对于碳化敷针钨阴极来说，针向钨表面的扩散速度要小得多。这是由于形成了碳化钨后钨丝表面就变得密实了。

这种阴极的严重缺点是由于碳渗透到钨丝的深处，因而使它的机械强度下降(变脆)。

§2. 阴极基金属的材料及其要求

阴极的基金属是电真空器件最重要零件之一，因此基金属材料的选择对电子管的质量具有决定性的意义。根据阴极不同的类型和用途，基金属应满足一系列的要求，当然，这些要求也是和用作直热式或旁热式阴极联系起来的。这些要求是：

1. 阴极基金属的材料应具有小的蒸发表度和高的熔点。
2. 阴极基金属材料的机械强度要大，再结晶温度应尽量地

高。

3. 基金屬材料的热傳导系数应小, 全幅射系数应小。

4. 阴極基金屬的材料应能很好地去气, 对于氧化物塗層以及在阴極的加工溫度时和整个管子的工作溫度下从电子管电極中逸出的气体应具有化学稳定性。

5. 基金屬的材料应有助于阴極的热發射性能。

对于阴極基金屬材料所提出的許多要求限制了用作基金屬的金属或合金的种类。

为了滿足上述要求, 在制造直热式阴極时通常采用型号为“ВЧ”的純鈮絲或含有硅鉛加成剂(含量不超过 0.1%)型号为“ВА”的鈮絲。由于在阴極工作过程中鈮絲不断的蒸發, 鈮絲的直徑就显著地变細, 因而导至器件參量的变化, 所以用在直热式阴極时, 鈮絲直徑的公差最好是正的。

在制造碳化敷鈎鈮阴極时, 采用型号为 BT10 和 BT15 的鈎鈮絲。其中以氧化鈎 ThO_2 作为加成剂。BT10 中 ThO_2 的含量为 1.0—1.5%。BT15 中 ThO_2 的含量为 1.5—2.5%。

为了制造直热式氧化物阴極, 采用复有鋁青銅(鋁的含量为 1—2%)的純鈮, 或者是常用的含硅鎳(硅的含量为 0.15—0.25%, 作为还原氧化鎳的激活剂用)。

通常, 中小功率器件直热式阴極的鈮絲直徑为 12—200 微米, 对于大功率的振蕩管則为 0.5—2 毫米。

为直热式阴極用的含硅鎳通常做成 100—200 微米的絲或寬度为 1—1.5 毫米的狭带。

目前, 在很多种电真空器件中, 特別是小功率直热式氧化物阴極的二極整流管中, 应用 НИВО-6 和 НИВО-30 鎳鎳合金絲作为基金屬是很成功的。在合金 НИВО-6 中含有 6% 的鎳, 在 НИВО-30 中含有 30% 的鎳。在阴極的工作溫度下, 这种合金具有高度的机

械强度。同时实验结果表明，这种合金对阴极的发射性能也起着良好的影响。

在某些情况下，如在高压二极整流管和气体放电器件中，阴极的氧化物涂层和基金属间应有大的粘着力，用含有钴和其他成分（见表 1-2，H-16 合金）的镍合金作为基金属的材料。显然，在这种合金中加入钴后，会增加氧化物涂层和基金属材料间的粘着力。

长久以来，在制造旁热式氧化物阴极时用“A”型含硅镍作为基金属的材料，其中硅的含量为 0.15—0.25%。多年来对于这种材料在电真空器件中的详细研究表明，用含硅镍作为基金属做成的阴极有很多严重的缺点，它们会大大地改变电子管的参数和运用数据。影响电子管的参数和寿命的因素之一是由于在工作温度（1000—1100°K）时，特别是在氧化物阴极的激活温度（~1300°K）

时，在基金属和涂层的交界处由于化学的机械的和物理的作用，会形成阻挡性质的中间层。这种中间阻层具有相当大的电阻（达数百欧姆）和电容（达数万微法）。

有了中间阻层后，在电子管的阴极电路中就产生了阻抗。此时，电子管的等效线路图可以用图 1-5 来表示。电阻 R_K 和电容 C_K 并联，而和电子管阴极电路中的元件串联。这对于二极管来说，会减低控制电子流的阳极电压，而对于三极管和多极管来说，则会引起电子管的栅偏压和负反馈。这几种因素都会减少电子管的跨导。

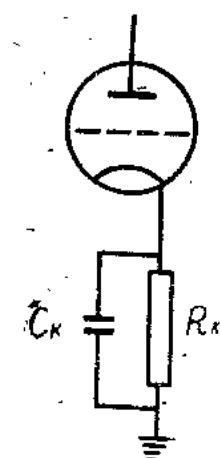


图 1-5. 当有中间层时
电子管的等效线路。

由于工作点的位移，电子管特性曲线的跨导 S' 就下降，对于固定栅偏压工作情况，跨导的减少可按下

式^④决定:

$$S' \cong S_0 \left(1 - \frac{\alpha S_0 R_K}{3} \right).$$

这里: S_0 —没有中间阻层时电子管的跨导;

α —电流分配系数。

由于中间阻层的阻抗所引起的负反馈, 在考虑到工作点的位移后, 电子管特性曲线的跨导(S'')将等于:

$$S'' \cong S' \frac{1 + \omega^2 R_K^2 C_K^2}{\sqrt{(1 + \alpha C_K R_K)^2 + \omega^2 R_K^2 C_K^2}}.$$

这里: ω —工作频率。

从上述公式中可看出, 电子管参数的变化与其特性曲线的起始跨导关系很大。例如, 当中间层电阻由零增加到 100 欧姆时, 如特性曲线的起始跨导为 10 毫安/伏, 则特性曲线的跨导将下降 65%, 如果电子管特性曲线的起始跨导为 1 毫安/伏, 则特性曲线的跨导只下降 14%。

显然, 中间阻层主要对于高跨导管(如 6Ж4, 6П9, 6Ж15 等)是危险的。对于低跨导管(如 6Ж8), 中间阻层对参数的影响不大。

由于形成了中间阻层后电子管的参数发生了变化, 电子管的运用数据也就大大地变坏了:

- a) 中间阻层的形成使跨导和阳极电流下降, 输出管的振荡功率和放大级的放大系数也就下降。
- b) 由于中间层的形成, 电子管的跨导就和频率有关, 因而使宽频带放大器的频应曲线发生畸变。
- c) 当电子管工作在脉冲情况时, 中间阻层的形成会使短脉冲

^④ М. А. Шенсенько, Н. А. Блескунов, Г. А. Востров, Научно-технический бюллетень ОКБ и завода п/з 720, №3, 12(1956).